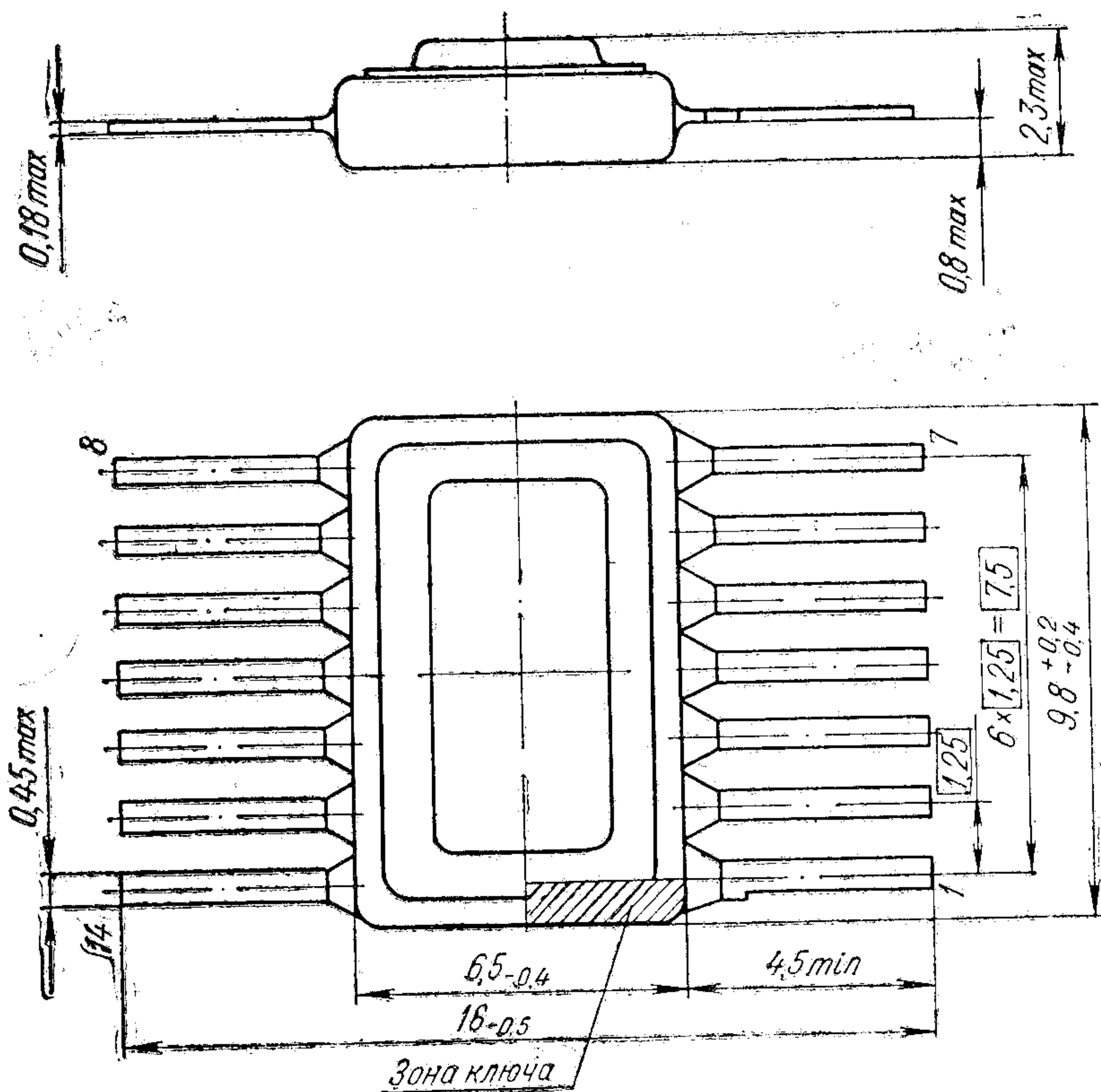


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 162

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ (КОРПУС 401.14-3)



Масса не более 0,36 г

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц

от 1 до 5000

амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

10 000 (1000)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 0,1 до 2,0

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 162

Общие данные

Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	160
Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	5 (665)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, $^{\circ}\text{C}$	85
Пониженная температура среды, $^{\circ}\text{C}$	минус 60
Изменения температуры среды, $^{\circ}\text{C}$	от минус 60 до +85
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка О, ч	50 000
Срок сохраняемости О, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11.073.041—82, ОСТ 11.073.040—82 и требованиями, изложенными ниже.

При монтаже микросхем должны быть приняты меры, исключающие изгиб выводов не более 3 раз под углом до 90° и должна обеспечиваться неподвижность вывода между основанием и местом изгиба.

Установка микросхем к печатной плате производится вплотную или с зазором до 0,7 мм с последующей прилакировкой и приклейкой клеями.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «корпус») к выводам микросхем, не используемым согласно принципиальной электрической схеме микросхемы.

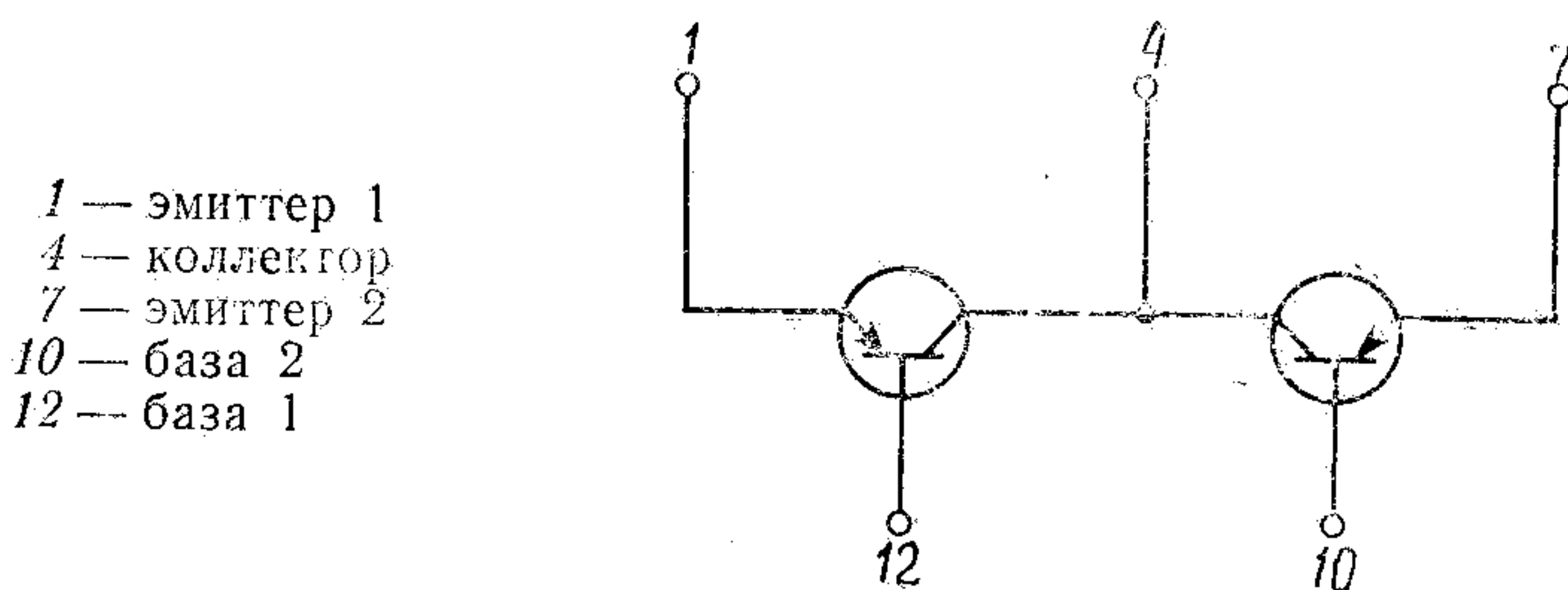
При ремонте аппаратуры замену микросхемы необходимо производить только при отключенных источниках питания.

После монтажа микросхемы должны быть защищены лаком УР-231 по ТУ 6-10-863—84. Количество слоев — 3. Опасное значение потенциала — 600 В.

Запрещается применять микросхемы при одновременном управлении по базам.

О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Напряжение между эмиттерами при $I_{упр}$ ($I_{б1} + I_{б2}$) = 2 мА, мкВ, не более:	
для микросхемы 162КТ1А	100
» » 162КТ1Б	200
Ток утечки между эмиттерами при $U_{ком}$ ($U_{э1, э2}$) = ±30 В, нА, не более	45
Сопротивление в открытом состоянии при $I_{ком}$ ($I_{э1, э2}$) = 100 мкА, $I_{упр}$ ($I_{б1} + I_{б2}$) = 2 мА, Ом, не более	100
Прямое напряжение на переходах коллектор — база при $I_{упр}$ ($I_{б1} + I_{б2}$) = 2 мА, В, не более	0,85
Остаточное напряжение на переходах эмиттер — коллектор при $I_{упр}$ ($I_{б1} + I_{б2}$) = 2 мА, мВ, не более	10
Напряжение между эмиттерами,* мкВ, не более	
для микросхемы 162КТ1А	200
» » 162КТ1Б	300
Ток утечки между эмиттерами*, нА, не более	100

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обратное напряжение коллектор — база, В	20
Коммутируемое напряжение, В	±30
Ток управления, мА:	
для микросхемы 162КТ1А	10
» » 162КТ1Б	20

* Электрические параметры в течение срока сохраняемости.

162КТ1А
162КТ1Б

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ПРЕРЫВАТЕЛЬ**

Ток коллектора, мА:

для микросхемы 162КТ1А	15
» » 162КТ1Б	25

Коммутируемый ток, мА:

для микросхемы 162КТ1А	2,5
» » 162КТ1Б	5,0